SOLAR CELL

Publication number: JP6204529 Publication date: 1994-07-22

Inventor: FUKAE KIMITOSHI

Applicant: CANON KK

Classification:

- international: H01L31/04; H01L31/04; (IPC1-7): H01L31/04

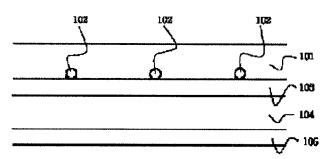
- European:

Application number: JP19920361501 19921228
Priority number(s): JP19920361501 19921228

Report a data error here

Abstract of JP6204529

PURPOSE:To provide a solar cell which has a unit cell of a large area and can be formed with high reliability and a low cost. CONSTITUTION: Conductive fine wires 102 are buried in one surface side of a thermoplastic light permeable insulating board 101, and a transparent conductive layer 103 as a first electrode, a solar cell layer 104 and a conductive layer 105 as a second electrode are sequentially formed in this order on one side surface. In this case, the board 101 is a glass board, and is desirably softened at 400 to 600 deg.C. The wire 102 is desirably a metal wire having 10 to 200mum of its diameter. Accordingly, an electric resistance of the first electrode side can be reduced, and an increase in an area of the cell can be realized.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-204529

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 31/04	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
		7376-4M	H 0 1 L 31/04	М

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2 (72)発明者 深江 公俊 東京都大田区下丸子3丁目30番2 ン株式会社内 (74)代理人 弁理士 福森 久夫	
(72)発明者 深江 公俊 東京都大田区下丸子3丁目30番2 ン株式会社内	
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 ン株式会社内	号
ン株式会社内	
	号キヤノ
(74)代理人 弁理士 福森 久夫	

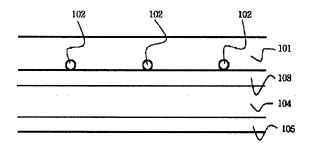
(54) 【発明の名称】 太陽電池

(57)【要約】

【目的】 本発明は、大面積の単一セルを有し、高信頼 度でかつ低コストで作ることを可能にする太陽電池を提 供することを目的とする。

【構成】 熱可塑性の透光性絶縁基板101の一面側に 導電性細線102を埋設し、該一面側に第一電極として の透明導電層103、太陽電池素子層104、第二電極 としての導電層105をその順序で形成する。ここで、 前記透光性絶縁基板101は、ガラス基板であり、40 0℃以上600℃以下の温度で軟化することが望まし い。また、前記導電性細線102は、その直径が10μ m以上200μm以下の金属ワイヤーであることが望ま しい。

【効果】 第一電極側の電気抵抗を下げることができ、 セルの大面積化を実現できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性の透光性絶縁基板の一面側に導 電性細線を埋設し、該一面側に第一電極としての透明導 電層、太陽電池素子層、第二電極としての導電層をその 順序で形成したことを特徴とする太陽電池。

【請求項2】 前記透光性絶縁基板は、ガラス基板であ り、400℃以上600℃以下の温度で軟化することを 特徴とする請求項1に記載の太陽電池。

【請求項3】 前記導電性細線は、その直径が10 μm 以上200μm以下の金属ワイヤーであることを特徴と 10 する請求項1又は請求項2に記載の太陽電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に大面積の単一セル を有する太陽電池に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、ガラス基板上に太陽電池を形成す る場合、該基板上に第一電板として透明導電膜を形成 し、次いで、光電変換層を形成し、さらにその上に第二 電極としての金属膜を形成するようにしている。一方、 太陽電池は、実用的には大面積のものが必要とされる が、上記構成のまま大面積化したのでは透明導電膜の電 気抵抗が大きすぎて、有効に電気を取り出すことができ ない。

【0003】従って、図6に示すような公知のレーザス クライビングなどの手法を用いて、セルを小区分化する と共に直列接続化し、単一セルからの出力電流を減らし モジュール全体の出力電圧を上げる構造としている。な お、図6中、601は透光性絶縁基板、602は第一の 電極としての透明導電膜、603は光電変換層、604 30 は第二の電極としての導電層である。

【0004】さらに、特開昭60-50975号公報に は、図7に示すごとく、ガラス基板701上にエッチン グ法を用いて溝702を形成し、該溝702に銀ペース ト703を埋め込むことによりグリッドを形成する手法 が提案されている。図7中、704は第一の電極として の透明導電膜、705は光電変換層、706は第二の電 極としての導電層である。

[0005]

図る従来のレーザスクライブ法では、ガラス基板上に成 膜した後レーザ光線を用いてセルを小区分に分割し、更 にそれらを直列接続しているので、1モジュール内での 直列接続の回数が増えることにより、非発電部分である 直列接続部分の面積が増大してしまうという問題点があ った。また、後者のガラス基板エッチング法ではエッチ ングのためのプロセスコストが高価となったり、銀ペー ストの電気抵抗金属に比べて1桁程高くなったり、キュ ア後の銀ペーストがポーラスとなってしまいその上に成 膜してもシャントを起こしたり、真空成膜中に銀ペース 50

ト中の成分が発散し光電変換層の膜質が悪化したりす る、等の問題点があった。

【0006】さらに、図6に示す従来型レーザスクライ ブ法では、セル幅が10ミリメートルを越えると透明導 電膜中での電力損失が大きくなってしまうので、セル幅 をそれ以上大きくできなかった。

【0007】本発明は、上述した従来の課題を解決し、 大面積の単一セルを髙信頼に低コストで作ることを可能 にしたものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ため本発明は、熱可塑性の透光性絶縁基板の一面側に導 電性細線を埋設し、該一面側に第一電極としての透明導 電層、太陽電池素子層、第二電極としての導電層をその 順序で形成したことを特徴とする。

【0009】この場合、前記透光性絶縁基板は、ガラス 基板であり、400℃以上600℃以下の温度で軟化す ることが望ましい。

【0010】また、前記導電性細線は、その直径が10 μ m以上200μ m以下の金属ワイヤーであることが望 ましい。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

【作用】図1において101は太陽電池の成膜基板であ る熱可塑性の透光性絶縁基板、102は導電性細線、1 03は第一電極としての透明導電膜、104は光電変換 層、105は第二電極としての導電層である。なお、電 流を取り出すためのリード取り出しや、耐候性を確保す るための背面の仕上げなどは通常の手法を用いて行な

【0012】図2は、図1の上方から見た図を示すもの である。導電性細線202は等間隔に多数本を平行して 配置する。前記熱可塑性の透光性絶縁基板201として は、通常のガラスを用いる。ガラスからの金属イオンの 拡散を抑えるため、ガラス表面に酸化珪素の皮膜を形成 しても良い。導電性細線には銅、アルミニウムなどの金 属ワイヤを用いることができる。

【0013】電流路中での電力損失と導電性細線自身の 陰によるシャドウロスの合計損失を最小にするためには できるだけ細い金属線を狭い間隔で配置するのが良い 【発明が解決しようとする課題】太陽電池の大面積化を 40 が、実用的には直径10~200ミクロン程度の金属ワ イヤ用いるのが良い。

> 【0014】光電変換層はアモルファスシリコン、結晶 シリコン、あるいは化合物半導体であっても良い。第二 電極としてはアルミニウムなどの蒸着が好適である。

> 【0015】図3は、導電性細線302を透光性絶縁基 板301に埋め込む方法を説明するものである。図中、 306は定盤、307は加熱装置を示している。308 は透光性絶縁基板301の全面を均一に押すための加圧 板である。

【0016】作製手順としては、まず、定盤306の上

3

に導電性細線302を載置し、その上に透光性絶縁基板 301を載せて加熱した。次いで、透光性絶縁基板30 1が軟化したら加圧板308で加圧し導電性細線302 をガラス中に押し込む。従って、導電性細線302の一 部が基板表面に顔を出した状態でワイヤーを埋め込むこ とができるので、透明導電膜との電気的なコンタクトを 十分に取ることが可能となる。定盤306の材質として はセラミック、鋼等が好適である。

[0017]

【実施例】(実施例1)本実施例では、図1における透 10 光性絶縁基板101として、厚さ3ミリ、10センチメ 一トル角のソーダガラスに真空蒸着法により700オン グストロームの酸化珪素膜を形成したものを用意した。 定盤106は、20cm角のセラミック製のものを用 い、該定盤106上に導電性細線102として、直径2 5オングストローム、長さ13センチメートルの断面形 状が丸い銅ワイヤーを2ミリ間隔で平行に配置した。こ の上に上記基板101を戴置し、更に加圧板108とし ての重量5キログラムのセラミック板をその上に戴置し た。

【0018】続いて、窒素ガス雰囲気中500℃で30 分間維持したところ銅ワイヤーが円柱状表面の一部をガ ラス基板表面に表したままガラス基板中に埋め込まれ た。これを成膜基板として、この hに I T O膜を 1 ミク ロン厚に、更にアモルファスシリコン光電変換層をn 層、1層、p層の順に2回形成し、セイムパンドギヤッ ブダブルタンデム構成の太陽電池を作製した。なお、第 二電極としてはアルミニウムを真空蒸着により1ミクロ ンの厚みに形成した。

【0019】上記のように作製された太陽電池セルをA 30 である。 M1. 5, 100 mW/c m2の標準光源で測定したと ころ、約7 %の変換効率が得られた。また、電力損失 と銅ワイヤー自体の影によるシャドウロスを合計した損 失は約3.5%であった。

【0020】(実施例2)本実施例は、モノリシック集 積型セルに応用したものである。図2に示すように、ま ず、ガラス基板201上に複数本の金属ワイヤー202 をその長手方向において断続的に配置し、上記第1の実 施例と同様に該ワイヤー202をがガラス基板201の 表面に埋め込んだ。そして、該ガラス基板201上に上 40 記実施例1と同条件で透明導電膜を形成し、図5 (a) に示すように、公知のレーザスクライブ技術を用い、透 明導電膜503のP₀の部分に1回目のレーザ光線を照 射する。なお、図5(a)において、501はガラス基 板であり、502はワイヤーである。

【0021】次に、図5(b)に示すように、前記透明 導電膜503上にアモルファスシリコン光電変換層50 4を形成し、P1部分に2回目のレーザ光線を照射し た。続いて、図5(c)に示すように、アルミニウム5 0.5を蒸着した段階で3回目のレーザ光線を P_2 部分に 50 1.0.5、5.0.5 第二電極としての導電層。

照射した。

【0022】本実施例によれば、第一電極部の導電性が 飛躍的に向上したために単位セルのセル幅を10cmに 広げることができ、レーザスクライブの回数を従来法に 比べ約90%減少できた。この結果、セル表面の非発電 部分の比率が約80%減少し、また、セル幅に自由度が 出るため、ある決められたモジュールサイズに対して自 由な電流値あるいは電圧値を取ることができるようにな った。

【0023】(実施例3)本実施例は、上記実施例1及 び実施例2における銅ワイヤーに代えて網状の導電体を 用いた。上記実施例では銅ワイヤーを2ミリ間隔で平行 に配置しただけの構成であったが、本実施例ではかかる 平行配置状態にした後、これに直交するようにさらに 2. 5ミリ間隔で同一材料の銅ワイヤーを配置して網状 に形成した。かかる構成にすると、シャドウロスは約1 %増加したが、セラミツク定盤上にワイヤーを並べる作 業性は飛躍的に向上した。また、網状の場合、一方の縦 糸ワイヤーが切断しても他方の横糸ワイヤーを介して隣 20 接ワイヤーに電流を運ぶことができるので便利である。

[0024]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、ガラス 基板上の第一電極側の電気抵抗を下げる事が可能とな り、従来より大面積の太陽電池セルを形成できるように なった。この結果、太陽電池の構成及び製造工程が簡略 化し、製品の信頼性が向上し、低価格化が可能となっ た。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る太陽電池の構成を示す模式断面図

【図2】図1の上面図である。

【図3】導電性細線の埋め込みを説明するための概略側 断面図である。

【図4】実施例2に係る太陽電池の構成を示すものであ り、(a)は上面図、(b)はX-X線に沿う断面図で ある。

【図5】セル集積化の各工程(a)~(c)の例を示す 図である。

【図6】従来の太陽電池セルの構成例を示す断面図であ

【図7】もう一つの従来の太陽電池セルの構成例を示す 断面図である。

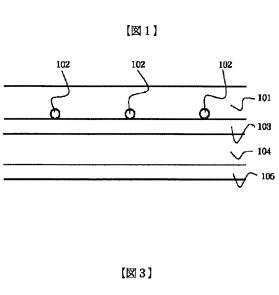
【符号の説明】

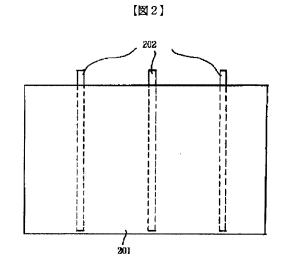
101、201、301、401、501 透光性絶縁 基板、

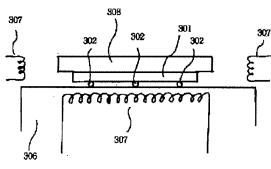
102、202、302、402、502 導電性細

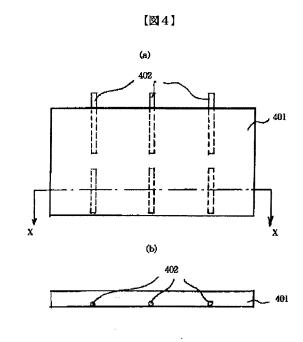
103、503 透明導電膜、

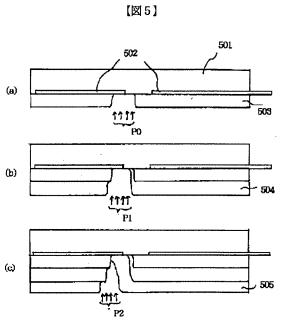
104、504 光電変換層、



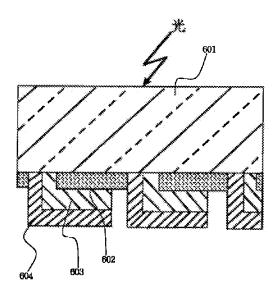








【図6】



【図7】

